

砷化镓电调变容二极管主要电特性参数 (T_A=25℃)

参数名称	击穿电压	反向电流	正向微分电阻	结电容	结电容变比	总电容	总电容变比	截至频率	封装类型
符 号	V _(BR)	I _R	r _F	C _{j(0)}	γ	C _{t(0)}	γ	f _c	—
测试条件	I _R =10μA	V _R =0.8V _(BR)	I _F =20mA f=50Hz	V _R =0V f=1MHz	C _{j0} /C _{jV(BR)}	V _R =0V f=1MHz	C _{t0} /C _{tV(BR)}	V _R =4V f=9.375GHz	—
单 位	V	nA	Ω	pF	—	pF	—	GHz	—
极限值 型号	最小	最大	最大	最大	最小	最大	最小	最小	—
WB62101~WB62109	15	15	—	—	—	0.6~1.0	2.9~3.5	50~120	W205
WB62111~WB62119	15	15	—	—	—	1.0~1.5	3.5~4.5	50~120	
WB62121~WB62129	15	15	—	—	—	1.5~2.5	4.2~5.8	50~120	
WB62131~WB62136	15	15	—	—	—	2.5~4.0	5.3~7.3	50~85	
WB62201~WB62209	20	15	—	—	—	0.6~1.0	2.9~3.5	50~120	
WB62211~WB62219	20	15	—	—	—	1.0~1.5	3.5~4.5	50~120	
WB62221~WB62229	20	15	—	—	—	1.5~2.5	4.2~5.8	50~120	
WB62231~WB62236	20	15	—	—	—	2.5~4.0	5.3~7.3	50~85	
WB2010	20	100	3.0	0.8~1.5	6.0	—	—	100	T182
WB2014H	20	100	3.0	—	—	1.2~2.0	4.5	50	W202
WB2015H	20	100	3.0	—	—	1.0~1.5	4.5	85	
WB2016H	30	100	3.0 _{@50mA}	11~13	8.0 _{@C_{j0}/C_{j20}}	—	—	10 _{@6V}	
WB0101	15	40	—	0.8~1.2	8.5	—	—	50	芯片
WB0102	15	40	—	1.2~1.7	9.0	—	—	45	
WB0103	15	40	—	1.7~2.5	9.5	—	—	40	
WB04011~04014	20	50	3.0	1.0~1.5	8~10	—	—	40~70	
WB04015~04018	20	50	3.0	0.5~1.0	7~10	—	—	50~100	
WB04021~04024	15	50	3.0	1.0~1.5	6~8	—	—	40~70	
WB04025~04028	15	50	3.0	0.5~1.0	5~7	—	—	50~100	

砷化镓常 γ 电调变容二极管主要电特性参数 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

参数名称	击穿电压	反向电流	正向微分电阻	总电容	总电容	总电容	电容变比	截至频率	封装类型
符 号	$V_{(BR)}$	I_R	r_F	$C_{T(-0)}$	$C_{T(-2)}$	$C_{T(-4)}$	γ	f_c	—
测试条件	$I_R=10\mu\text{A}$	$V_R=0.8V_{(BR)}$	$I_F=20\text{mA}$ $f=50\text{Hz}$	$V_R=0V$ $f=1\text{MHz}$	$V_R=2V$ $f=1\text{MHz}$	$V_R=4V$ $f=1\text{MHz}$	$C_{T0}/C_{TV(BR)}$	$V_R=4V$ $f=9.375\text{GHz}$	—
单 位	V	nA	Ω	pF	pF	pF	—	GHz	—
型号	极限值 最小	最大	最大	最大	最大	最大	最小	最小	—
WB64711~64714	15	15	3.0	1.2~2.5	—	—	4.5~6.0	40~50	W205
WB64721~64724	20	15	3.0	1.2~2.5	—	—	4.5~6.0	40~50	
WB64811~64814	15	15	3.0	0.75~1.2	—	—	3.5~4.0	50~80	
WB64821~64824	20	15	3.0	0.75~1.2	—	—	3.5~4.0	50~80	
WB70101	15	15	—	3.0~4.0	1.5~3.0	—	7.0	40	T209
WB70102	15	15	—	3.0~4.0	1.5~3.0	—	7.0	60	
WB70111	15	15	—	3.0~4.0	1.5~3.0	—	8.0	40	
WB70112	15	15	—	3.0~4.0	1.5~3.0	—	8.0	60	
WB70201	15	15	—	4.0~5.5	1.5~3.0	—	7.5	40	
WB70202	15	15	—	4.0~5.5	1.5~3.0	—	7.5	60	
WB70211	15	15	—	4.0~5.5	1.5~3.0	—	8.5	40	
WB70212	15	15	—	4.0~5.5	1.5~3.0	—	8.5	60	
WB7611	15	15	3.0	2.0~3.5	—	—	4.7	40	T129
WB7612	15	15	3.0	2.0~3.5	—	—	4.7	70	
WB7613	15	15	3.0	2.0~3.5	—	—	5.5	40	
WB7614	15	15	3.0	2.0~3.5	—	—	5.5	70	
WB7615	15	15	3.0	2.0~3.5	—	—	6.3	40	
WB7616	15	15	3.0	2.0~3.5	—	—	6.3	70	
WB7621	18	15	3.0	3.5~5.0	—	—	5.7	40	
WB7622	18	15	3.0	3.5~5.0	—	—	5.7	60	
WB7623	18	15	3.0	3.5~5.0	—	—	6.4	40	
WB7624	18	15	3.0	3.5~5.0	—	—	6.4	60	
WB7625	18	15	3.0	3.5~5.0	—	—	7.1	40	
WB7626	18	15	3.0	3.5~5.0	—	—	7.1	60	
WB7631	18	15	3.0	5.0~7.0	—	—	6.3	40	
WB7632	18	15	3.0	5.0~7.0	—	—	7.4	40	
WB7633	18	15	3.0	5.0~7.0	—	—	8.5	40	
WB2005HA	15	50	3.0	(0.5~1.0) ^a	—	—	4.5	50 _{@6V}	
WB2005HB	15	50	3.0	(1.0~2.0) ^a	—	—	5.5	50 _{@6V}	
WB2005HC	15	50	3.0	(2.0~3.0) ^a	—	—	6.5	50 _{@6V}	
WB2005HD	15	50	3.0	(3.0~5.0) ^a	—	—	7.5	50 _{@6V}	
WB2007A	20	100	3.0	10~12	—	—	8.0	10	W205
WB2007B	30	100	3.0	10~12	—	—	8.0	10	
WB2011H	20	—	2.5	—	—	7~10	10.0	10 _{@500MHz}	

注：a 此电容值为零偏压结电容。

砷化镓倍频变容二极管主要电特性参数 (T_A=25℃):

参数名称	击穿电压	反向电流	正向微分电阻	结电容	电容变比	优值	截至频率	封装类型
符 号	V _(BR)	I _R	r _F	C _{j(0)}	γ	Q	f _c	—
测试条件	I _R =10μA	V _R =0.8V _(BR)	I _F =20mA f=50Hz	V _R =0V f=1MHz	C _{j0} /C _{jV_(br)}	V _R =0V f=9.375GHz	V _R =6V f=9.375GHz	—
单 位	V	nA	Ω	pF	—	—	GHz	—
极限值 型号	最小	最大	最大	最大	最小	最小	最小	—
WB6012A	20	15	3.0	0.5~0.75	3.0	8	—	W205
WB6012B	20	15	3.0	0.5~0.75	3.0	10	—	
WB6022A	20	15	3.0	0.75~1.0	3.0	5	—	
WB6022B	20	15	3.0	0.75~1.0	3.0	8	—	
WB6031	10	15	3.0	1.0~1.5	2.5	4.5	—	
WB6032	20	15	3.0	1.0~1.5	3.2	4.5	—	
WB6033	30	15	3.0	1.0~1.5	3.8	4.0	—	
WB6041	10	15	3.0	1.5~2.0	2.7	3.5	—	
WB6042	20	15	3.0	1.5~2.0	3.5	3.5	—	
WB6043	30	15	3.0	1.5~2.0	4.0	3.5	—	
WB6051	10	15	3.0	2.0~3.0	2.7	3.0	—	
WB6052	20	15	3.0	2.0~3.0	3.5	3.0	—	
WB6053	30	15	3.0	2.0~3.0	4.0	3.0	—	
WB751	15	15	2.0 _{@50mA}	0.08~0.20	—	—	100	
WB752	20	15	2.0 _{@50mA}	0.08~0.20	—	—	100	
WB2004A	25	100	3.0	0.35~0.45	2.0	—	100	T209
WB2004B	25	100	3.0	0.35~0.45	2.0	—	200	
WB2004C	25	100	3.0	0.45~0.55	2.3	—	100	
WB2004D	25	100	3.0	0.45~0.55	2.3	—	200	
WB2004E	25	100	3.0	0.55~0.65	2.6	—	100	
WB2004F	25	100	3.0	0.55~0.65	2.6	—	150	
WB2006	15	100	3.0	0.15~0.25	1.5	—	100	W121
WB2008A	25	100	3.0	0.5~1.5	3.0	—	50 _{@4V}	F25-1
WB2008B	35	100	3.0	0.5~1.5	4.0	—	50 _{@4V}	
WB2009H	15	100	3.0 _{@40mA}	0.1~0.2	1.5	—	20	T129
WB2012	15	100	3.0	0.15~0.25	—	—	550	T089
WB2002	20	50	3.0	0.1~0.3	—	—	100	芯片

硅电调变容二极管主要电特性参数 (T_A=25℃):

参数名称	击穿电压	反向电流	正向微分电阻	总电容	总电容	总电容	电容变比	优值	截至频率	封装类型
符 号	$V_{(BR)}$	I_R	r_F	$C_{t(-2)}$	$C_{t(-4)}$	$C_{t(-20)}$	γ	Q	f_c	—
测试条件	$I_R=10\mu A$	$V_R=60V$	$I_F=20mA$ $f=50Hz$	$V_R=2V$ $f=1MHz$	$V_R=4V$ $f=1MHz$	$V_R=20V$ $f=1MHz$	C_{t-4}/C_{t-60}	$V_R=4V$ $f=9.375$ GHz	$V_R=4V$ $f=9.375$ GHz	—
单 位	V	nA	Ω	pF	pF	pF	—	—	GHz	—
极限值 型号	最小	最大	最大	最大	最大	最大	最小	最小	最小	—
WB1001A	—	100	2.5	—	60~100	—	2.0~3.5	120	—	D0-7
WB1001B	—	100	2.5	—	60~100	—	3.5~4.5	120	—	
WB1001C	—	100	2.5	—	78~86	—	3.0~3.2	150	—	
WB1001D	—	100	2.5	—	78~86	—	3.4~3.6	150	—	
WB1001E	—	100	2.5	—	78~86	—	3.0~3.6	120	—	
WB1001F	—	100	2.5	—	78~86	—	3.2~3.4	150	—	
WB3321	50	15@40V	2.2	—	1.0~1.2	—	5.0@C _{t0} /C _{t-50}	—	—	T209
WB3322	50	15@40V	2.2	—	1.0~1.2	—	5.5@C _{t0} /C _{t-50}	—	60	
WB3323	50	15@40V	2.2	—	1.0~1.2	—	6.0@C _{t0} /C _{t-50}	—	60	
WB3324	50	15@40V	2.2	—	1.0~1.2	—	6.5@C _{t0} /C _{t-50}	—	50	
WB3331	50	15@40V	2.2	—	1.2~1.5	—	5.0@C _{t0} /C _{t-50}	—	50	
WB3332	50	15@40V	2.2	—	1.2~1.5	—	5.5@C _{t0} /C _{t-50}	—	50	
WB3333	50	15@40V	2.2	—	1.2~1.5	—	6.0@C _{t0} /C _{t-50}	—	50	
WB3334	50	15@40V	2.2	—	1.2~1.5	—	6.5@C _{t0} /C _{t-50}	—	50	
WB1015A	—	100@12V	0.6@100mA	96~144	—	—	7@C _{t-2} /C _{t-10}	200@2V, 1MHz	—	D0-7
WB1015B	—	100@12V	0.6@100mA	96~144	—	—	10@C _{t-2} /C _{t-10}	200@2V, 1MHz	—	
WB1016	40	50@40V	1.2@50mA	—	1.4~1.8	—	6.5@C _{t0} /C _{t-40}	800@4V, 50MHz	—	T209
WB1017H	—	100@25V	1.5@30mA	19~25	(3~5)@10V	—	5.0@C _{t-2} /C _{t-10}	200@4V, 50MHz	—	W202
WB1020H	—	100@25V	2.0	60@0V	(22~28)@3V	7@10V	—	30@10V, 500MHz	—	W304
WB1021H	—	100@20V	1.5@30mA	40~55	35~45	(23~33)@10V	—	200@4V, 50MHz	—	D0-7
WB1009A	35	—	1.6	—	(5~6)@9V	(2~2.5)@22V	2@C _{t-9} /C _{t-22}	50@20V, 500MHz	—	W205
WB1009B	35	—	2.0	—	(5~7)@9V	(2~3)@22V	2@C _{t-9} /C _{t-22}	50@20V, 500MHz	—	
WB1010	20	—	3.0	—	0.72~0.88	0.30~0.38	7@C _{t0} /C _{t-20}	450@4V, 50MHz	—	
WB1011	20	—	3.0	—	0.90~1.10	0.34~0.42	7@C _{t0} /C _{t-20}	450@4V, 50MHz	—	
WB1012	20	—	3.0	—	3.51~4.29	0.93~1.18	7@C _{t0} /C _{t-20}	300@4V, 50MHz	—	
WB1013	20	—	3.0	—	0.60~0.76	0.18~0.26	9@C _{j0} /C _{j-20}	450@4V, 50MHz	—	芯片
WB1014	20	—	3.0	—	0.78~1.00	0.22~0.30	9@C _{j0} /C _{j-20}	450@4V, 50MHz	—	
WB0933H	—	100@45V	0.5@100mA	—	29~35	—	2.5@C _{t-4} /C _{t-45}	15@4V, 50MHz	—	D0-7

硅功率变容二极管主要电特性参数 (T_A=25℃):

参数名称	击穿电压	反向电流	结电容	电容变比	电容变比	电容变比	优值	截至频率	封装类型
符 号	$V_{(BR)}$	I_R	$C_{j(0)}$	γ_1	γ_2	γ_3	Q	f_c	—
测试条件	$I_R=10\mu A$	$V_R=30V$	$V_R=0V$ $f=1MHz$	$C_{j0}/C_{j(-6)}$	$C_{j-13}/C_{j(-6)}$	$C_{j-35}/C_{j(-6)}$	$V_R=6V$ $f=500MHz$	$V_R=6V$ $f=500MHz$	—
单 位	V	μA	pF	—	—	—	—	GHz	—
极限值 型号	最小	最大	最大	最小	最小	最小	最小	最小	—
WB1006H	—	1	1.5~2.5	1.2~1.7	0.75~0.95	—	—	50	T3011
WB1007H	60	—	1.5~2.5	1.2~1.7	—	0.7~0.9	30	—	T556
WB1008H	50	—	5.0~7.0	1.2~1.7	—	0.7~0.9	50	—	T556